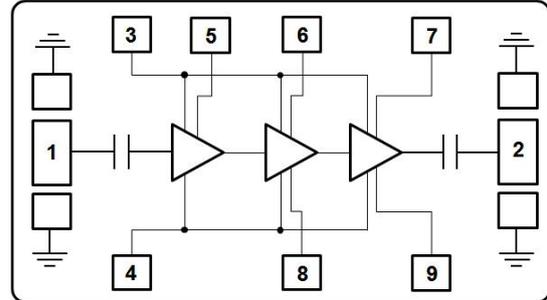




主要特点

- 工作频段: 34 – 36 GHz
- 小信号增益: 20 dB
- P_{sat} : 29.5 dBm
- PAE: 23 %
- 静态电流: 430 mA
- 动态电流: 690 mA
- 芯片尺寸: $3.0 \times 2.0 \times 0.1 \text{ mm}^3$

功能框图

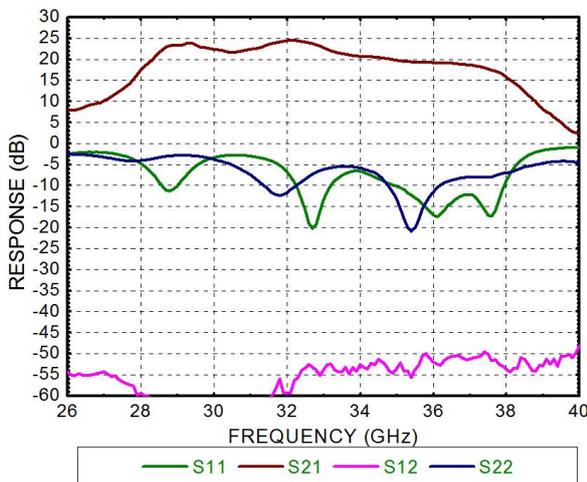


性能指标 ($T_A = +25^\circ\text{C}$, $V_D = +6 \text{ V}$)

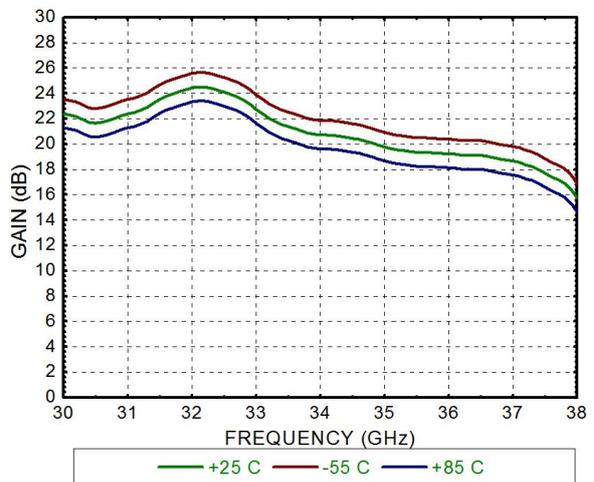
参数	最小	典型	最大	单位
工作频段	34 – 36			GHz
小信号增益		20		dB
输入回波损耗		10		dB
输出回波损耗		10		dB
反向隔离度		50		dB
饱和输出功率		29.5		dBm
PAE		23		%
静态工作电流*		430		mA
动态工作电流		690		mA

*通过调节 VG 使放大器偏置在该静态电流，典型值为-0.55V，可调范围为-1V~0V。

S参数

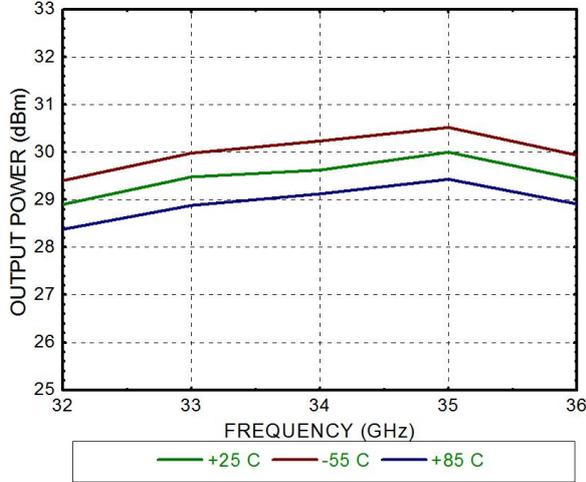


小信号增益

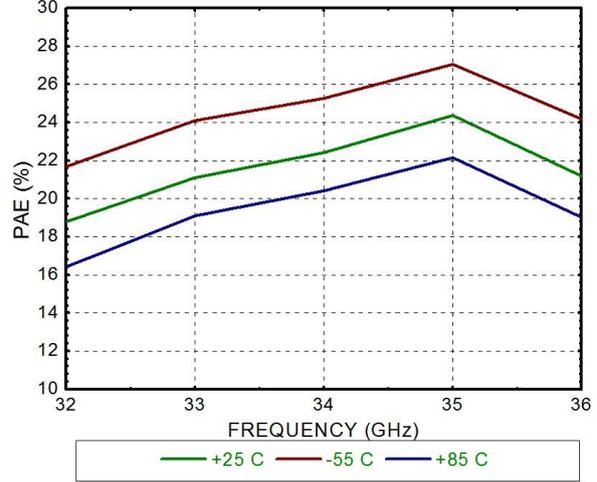




饱和输出功率

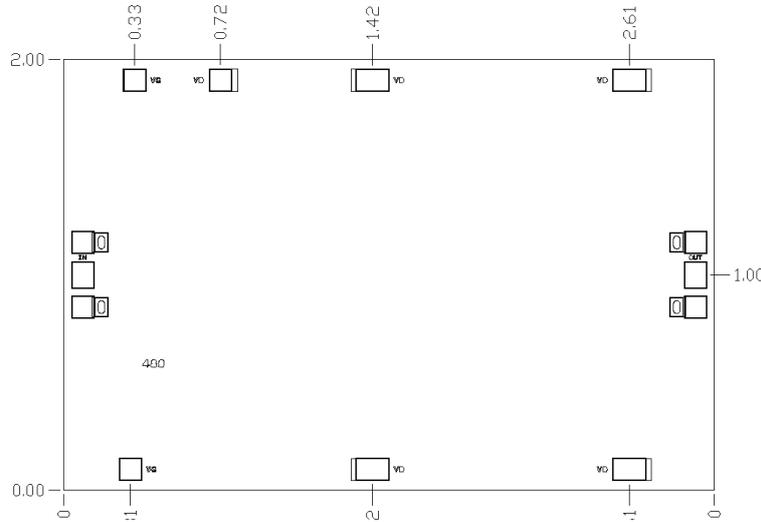


功率附加效率



物理参数

单位: mm

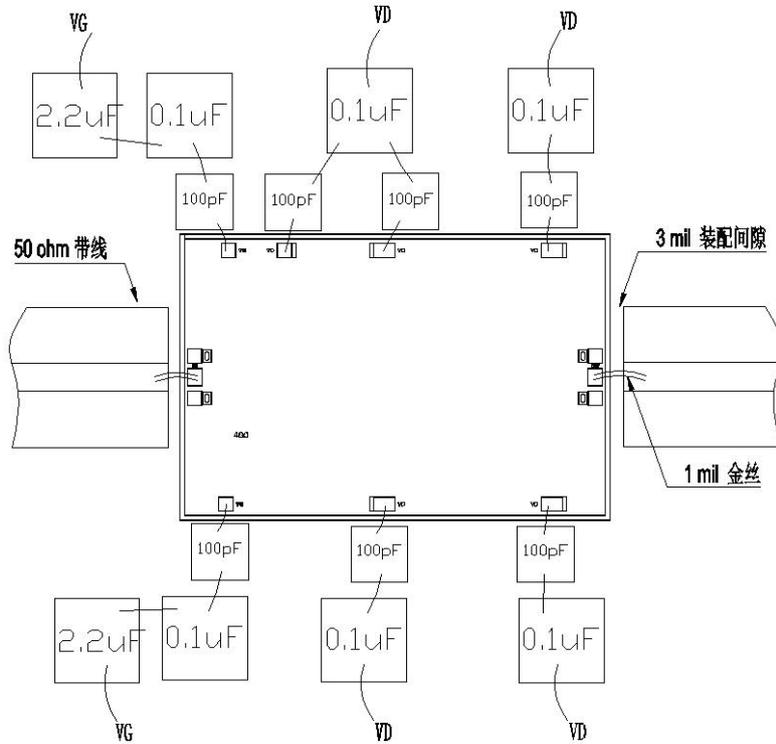


焊盘描述

焊盘序号	功能	描述
1	IN	该焊盘是 AC 耦合, 片上集成了隔直电容, 匹配至 50 Ohm
2	OUT	该焊盘是 AC 耦合, 片上集成了隔直电容, 匹配至 50 Ohm
3、4	VG	负电源电压, 推荐使用-0.55V
5、6、7、8、9	VD	正电源电压, 推荐使用+6V
芯片背面	GND	芯片背面必须连接至 RF/DC 地



装配图



注意事项

1. 推荐采用 AuSn 焊料共晶烧结工艺
2. 键合焊盘金属化: 金
3. 芯片背面镀金
4. 芯片背面接地
5. 本产品采用空气桥工艺, 表面不带钝化层

极限参数

1. 射频输入功率: +18dBm
2. 正电源电压: +7V
3. 负电源电压: -2V~0V
4. 工作温度: -55~+85°C
5. 储存温度: -65~+150°C
6. 沟道温度: 150°C